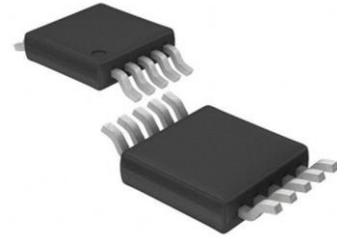


16-Bit、四输入、内置基准模数转换器

产品简述

MS5175 是一款高精度、可连续转换的 16bit 模数转换器，具有 4 路单端输入通道和内部集成 2.048V 基准，且使用 I²C 兼容接口。MS5175 电源范围为 2.7V 到 5.5V，转换速率为 15、30、60 或 240SPS，集成可编程增益放大器。在单次转换模式中，MS5175 在转换结束后会自动进入省电模式，减小功耗。

MS5175 可用在高精度测量以及对空间、功耗有一定要求的应用场合中，如：手持仪器、工业控制和智能变送器。



MSOP10

主要特点

- 4 路单端输入通道
- I²C 接口，8 个可编程地址
- 片上基准：2.048V±0.5%
- 温度漂移：10ppm/°C
- 内部集成 PGA：1 到 8 倍
- 16 位无失码精度
- INL（积分非线性误差）：0.01%
- 工作电压范围：2.7V 到 5.5V
- 低电源功耗：290uA

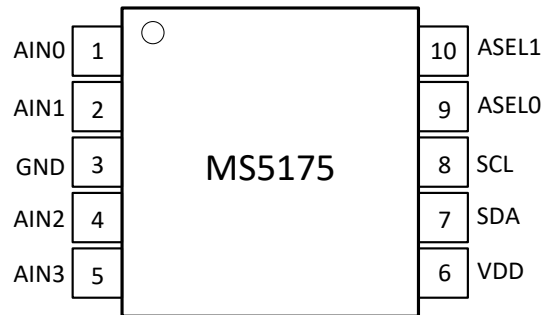
应用

- 手持仪器
- 工业级控制
- 智能变送器
- 工业自动化
- 温度测量

产品规格分类

产品	封装形式	丝印名称
MS5175	MSOP10	MS5175

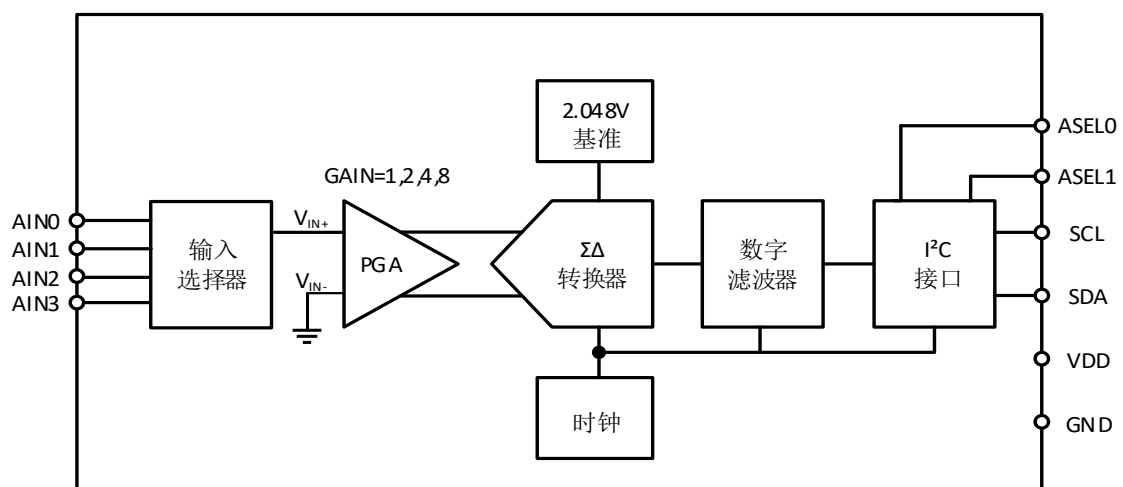
管脚图



管脚说明

管脚编号	管脚名称	管脚属性	管脚描述
1	AIN0	I	单端输入 1
2	AIN1	I	单端输入 2
3	GND	-	地
4	AIN2	I	单端输入 3
5	AIN3	I	单端输入 4
6	VDD	-	电源
7	SDA	I/O	串行数据发送接收端口
8	SCL	I/O	串行时钟输入, 时钟输出端口
9	ASELO	I	I ² C 从地址选择 1
10	ASEL1	I	I ² C 从地址选择 2

内部框图



极限参数

芯片使用中，任何超过极限参数的应用方式会对器件造成永久的损坏，芯片长时间处于极限工作状态可能会影响器件的可靠性。极限参数只是由一系列极端测试得出，并不代表芯片可以正常工作在此极限条件下。

参数	符号	额定值	单位
供电电压	VDD	-0.3 ~ 6	V
输入电流	IIN	100mA, 瞬间电流	mA
输入电流	IIN	10mA, 持续电流	mA
模拟输入 (ASELO,ASEL1 到 GND)	VIN	-0.3 ~ VDD+0.3	V
SDA, SCL 电压到地	V	-0.5 ~ 6	V
最大结温	T	150	°C
工作温度	TA	-40 ~ 125	°C
存储温度	Tstg	-60 ~ 150	°C
焊接温度	T	260	°C

电气参数

若无特别说明，测试条件：-40°C 到 85°C，VDD=5V。

参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
模拟输入					
正满幅输入电压范围	VIN+		+2.048/PGA		V
模拟输入电压	VIN+到 GND	GND-0.3		VDD+0.2	V
输入阻抗	PGA=1		3.5		MΩ
	PGA=2		3.5		MΩ
	PGA=4		1.8		MΩ
	PGA=8		0.9		MΩ
系统参数					
分辨率与无失码精度	DR=00		11		Bits
	DR=01		13		Bits
	DR=10		14		Bits
	DR=11		16		Bits
输出速率	DR=00	180	240	308	SPS
	DR=01	45	60	77	SPS
	DR=10	22	30	39	SPS
	DR=11	11	15	20	SPS
积分非线性误差	DR=11, PGA=1, 结束点 ¹		±0.004	±0.010	% of FSR ²
失调误差	PGA=1		3.9	8	mV
	PGA=2		3.8	5	mV
	PGA=4		3.8	4.5	mV
	PGA=8		3.5	4.5	mV
失调偏移	PGA=1		1.2		uV/°C
	PGA=2		0.6		uV/°C
	PGA=4		0.3		uV/°C
	PGA=8		0.3		uV/°C
失调 vs VDD	PGA=1		800		uV/V
	PGA=2		400		uV/V
	PGA=4		200		uV/V
	PGA=8		150		uV/V

参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
系统参数					
增益误差			1	1.5	%
PGA 增益匹配误差 ³	任意两个增益匹配		0.02	0.1	%
增益误差偏移			10		ppm/°C
增益 vs VDD			80		ppm/V
共模抑制比	直流输入, PGA=8	95	105		dB
	直流输入, PGA=1		100		dB
数字输入/输出					
输入高电平		0.7×VDD		VDD+0.5	V
输入低电平		GND-0.5		0.3×VDD	V
输出低电平	I _{OL} =3mA	GND		0.4	V
输入高电平峰值电流				10	uA
输入低电平峰值电流		-10			uA
电源参数					
工作电压	VDD	2.7		5.5	V
电源电流	关断状态		0.05	2	uA
	工作状态		290	350	uA
功率消耗	VDD=5.0V		1.45	1.75	mW
	VDD=3.0V		0.87		mW

注：1.满幅度的 99%。

2. FSR=满幅度量程=2×2.048/PGA=4.096/PGA。

3.包括 PGA 和基准的所有误差。

功能描述

MS5175 是一个 16 位、四通道输入、 Σ - Δ 型模/数转换器，其设计简单、极易配置的特点使得用户很容易获得精确的测量值。

模/数转换器

MS5175 的模/数转换器核由一个开关电容 Σ - Δ 调制器和一个数字滤波器组成。

输入选择器

MS5175 可提供四组单端输入通道，由 2 位配置寄存器位控制输入选择器。

电压基准

MS5175 内置一个 2.048V 的片内电压基准，无需外部基准。

输出码计算

MS5175 输出码的位数取决于更新速率，如表 1 所示。

表 1. 最大码

更新速率	位数	最大码（最高位为符号位）
15SPS	16	32767
30SPS	15	16383
60SPS	14	8191
240SPS	12	2047

MS5175 输出码的格式为二进制补码，右对齐且经过符号扩展。对不同输入电平的输出码见表 2。

表 2. 针对不同输入信号的输出码

更新速率	输入信号		
	0（理想）	+1LSB	+2.048V
15SPS	0000H	0001H	7FFFH
30SPS	0000H	0001H	3FFFH
60SPS	0000H	0001H	1FFFH
240SPS	0000H	0001H	07FFH

注：不要使输入电压低于 GND。

输出码可由以下表达式计算出：

$$\text{输出码} = 1 \times \text{最大码} \times \text{PGA} \times \frac{(V_{IN+}) - (V_{IN-})}{2.048V} \dots\dots\dots (V_{IN+} \geq V_{IN-})$$

MS5175 最大码是 $2^{n-1}-1$ 。

时钟振荡器

MS5175 内置时钟振荡器，该振荡器驱动调制器和数字滤波器。无需外部时钟。

表 3. 时序图的相关定义

参数		最小值	最大值	单位
t(SCLK)	SCLK 工作频率		0.4	MHz
t(BUF)	总线 START 到 STOP 的空闲时间	600		ns
t(HDSTA)	START 信号保持时间	600		ns
t(SUSTA)	重复 START 信号建立时间	600		ns
t(SUSTO)	STOP 信号建立时间	600		ns
t(HDDAT)	数据保持时间	0		ns
t(SUDAT)	数据建立时间	100		ns
t(LOW)	SCLK 时钟低电平周期	1300		ns
t(HIGH)	SCLK 时钟高电平周期	600		ns
t _F	时钟/数据下降时间		300	ns
t _R	时钟/数据上升时间		300	ns

串行总线地址

对 MS5175 进行读写，主机须通过地址位对从机寻址。从机地址位包括 7 个地址位，1 个操作位。

MS5175 有两个地址管脚，ASELO 和 ASEL1，可以设置 I²C 的地址。这个管脚可以设置为逻辑低、逻辑高或悬空。通过两个管脚可以设置 8 个地址，如表 4 所示。在上电复位或 I²C 总呼叫命令之后，器件将对 ASELO 和 ASEL1 管脚状态进行采样。

表 3. MS5175 地址脚与从机地址关系

ASELO	ASEL1	从机地址
0	0	1001000
0	悬空	1001001
0	1	1001010
1	0	1001100
1	悬空	1001101
1	1	1001110
悬空	0	1001011
悬空	1	1001111
悬空	悬空	无效

I²C 总呼叫

如果地址位 8 位都为 0 时，MS5175 响应总呼叫。器件应答总呼叫并响应第二个字节的命令。如果该命令为 04h，MS5175 将只锁存地址管脚 ASELO 和 ASEL1 的状态，并不复位配置寄存器。如果命令为 06h，MS5175 将锁存地址管脚的状态，并复位配置寄存器。

I²C 数据速率

I²C 总线有三种速度：标准方式，允许最高 100kHz 的时钟频率。快速方式，允许最高 400kHz 的时钟频率。高速方式，允许最高 3.4MHz 的时钟频率。

关于高速方式的更多信息，参考 I²C 规格说明。

结果寄存器

16 位的结果寄存器存储转换结果，采用二进制补码格式。在复位或上电之后，结果寄存器清 0，直到第一次转换完成。结果寄存器的格式如表 5 所示。

表 5. 结果寄存器

Bit	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0

配置寄存器

8 位配置寄存器控制 MS5175 的工作模式、更新速率和可编程增益放大器(PGA)。配置寄存器的格式如表 6 所示，默认设置是 8C_H。

表 6. 配置寄存器

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Name	ST/DRDY	INP1	INP0	SC	DR1	DR0	PGA1	PGA0
Default	1	0	0	0	1	1	0	0

位 7: ST/DRDY

ST/DRDY 位的含意取决于它是写入还是读出。

在单次转换模式中，写 1 到 ST/DRDY 位则表示转换的开始，写入 0 则无影响，在连续方式中，MS5175 忽略写入 ST/DRDY 的值。

在连续转换模式中，ST/DRDY 位确定新转换数据是否就绪。如果 ST/DRDY 为 1，则表示结果寄存器中的数据已经被读取；如果 ST/DRDY 为 0，则表示结果寄存器中的数据是未被读取的新数据。

在单次转换模式中，ST/DRDY 位确定转换是否完成。如果 ST/DRDY 为 1，则表示结果寄存器的数据为旧数据，而且转换正在进行。如果 ST/DRDY 为 0，则表示结果寄存器的数据是新转换的结果。

MS5175 先输出结果寄存器的值，再输出配置寄存器值。ST/DRDY 位的状态适用于刚从结果寄存器中读取的数据，而不是下一次读操作读取的数据。

位 6-5: INP

输入信号选择位。如表 7 所示，通过控制这两位，可以用来选择 4 个单端输入通道。

表 7. INP 位

INP1	INP0	VIN
0 (默认值)	0 (默认值)	AIN0
0	1	AIN1
1	0	AIN2
1	1	AIN3

位 4: SC

转换模式选择位。当 SC 为 1 时，选择单次转换模式；当 SC 为 0 时，选择连续转换模式。默认为 0。

位 3-2: DR

更新速率选择位，如表 8 所示。

表 8. DR 位

DR1	DR0	更新速率	精度
0	0	240SPS	12 位
0	1	60SPS	14 位
1	0	30SPS	15 位
1 (默认值)	1 (默认值)	15SPS	16 位

位 1-0: PGA

增益设置选择位，如表 9 所示。

表 9. PGA 位

PGA1	PGA0	增益
0 (默认值)	0 (默认值)	1
0	1	2
1	0	4
1	1	8

读操作

读取结果寄存器和配置寄存器的值。先对 MS5175 寻址，再从器件中读出 3 个字节。前 2 个字节是结果寄存器的值，第 3 个字节是配置寄存器的值。

可不读出配置寄存器，在读操作中允许读出的字节个数少于 3 个。如果读取多于 3 个字节，从第 4 个字节开始将为 FF_H。

MS5175 的典型读操作的时序见图 2。

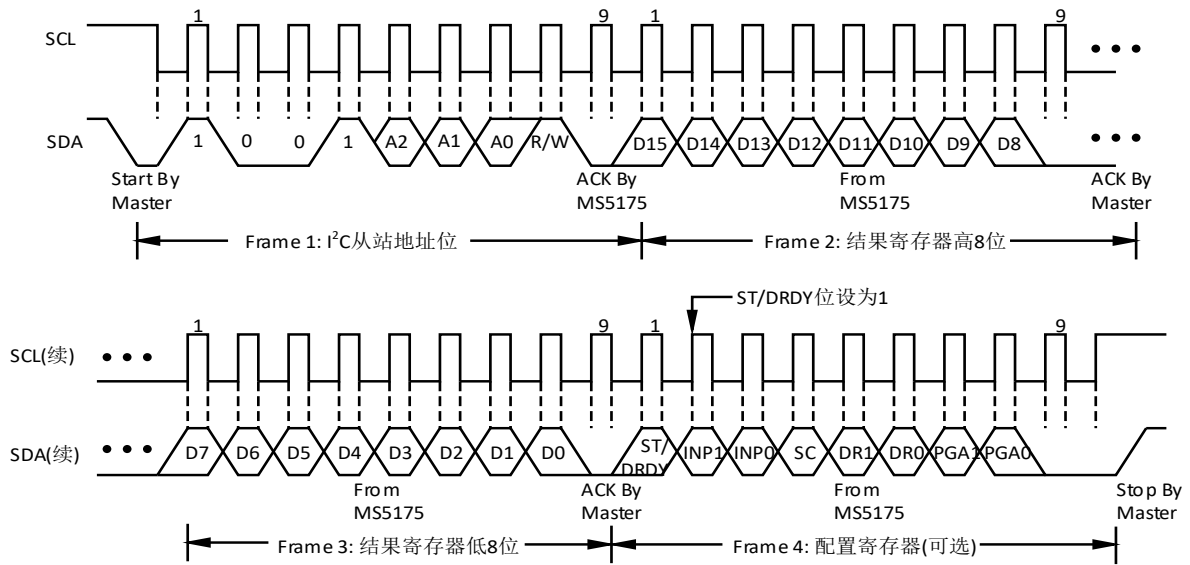


图 2. MS5175 的读操作时序图

写操作

对配置寄存器进行写操作。先对 MS5175 寻址，再写入一个字节，这个字节将被写入配置寄存器中。

写入多个字节无效，将忽略第一个字节之后的任何字节。MS5175 写操作的典型时序见图 3。

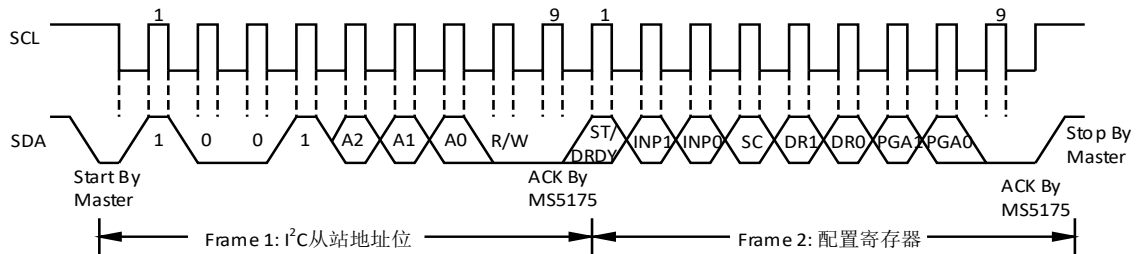


图 3. MS5175 的写时序

应用说明

基本连接方法

对于多数应用而言，MS5175 的典型基本连接图如图 4 所示。

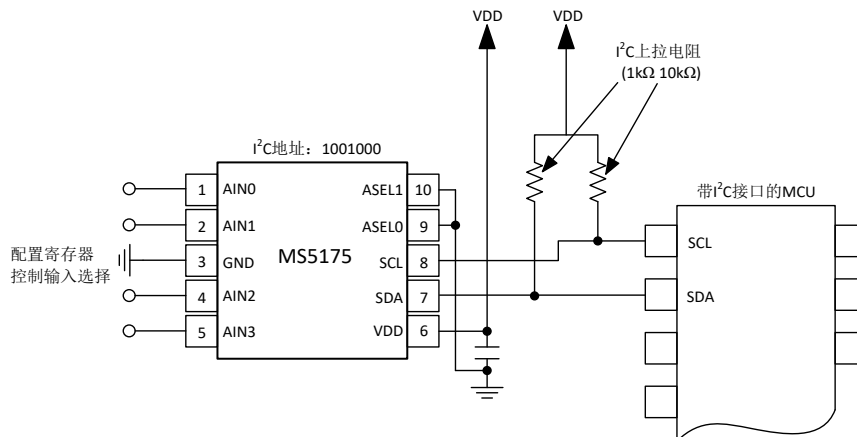


图 4. MS5175 的典型连接方法

连接多个器件

一条 I²C 总线可连接多个 MS5175。使用 ASELI 和 ASELO 脚，MS5175 可以设置为 8 种不同 I²C 地址。如图 5 所示，三个 MS5175 连接到同一条总线的接线图。一条 I²C 总线上最多可以连接 8 个 MS5175（使用不同状态的 ASELI 和 ASELO 脚进行控制）。

注意，I²C 总线仅需一组上拉电阻。

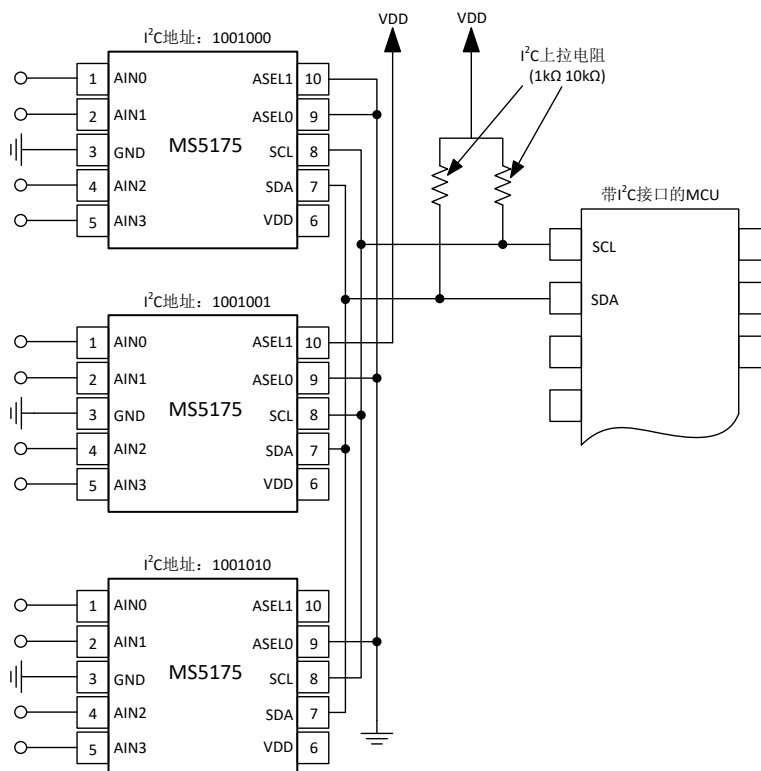


图 5. 连接多个 MS5175

低端电流监控器

图 6 是低端电流监控器的电路图。该电路通过一个检流电阻来读取电压。此电阻上电压可用低漂移的运放 MS8552 放大，放大结果由 MS5175 读取。

建议 MS5175 工作在 8 倍增益下，可以降低 MS8552 的增益。对于 8 倍增益而言，运放应提供最高不高于 0.256V 的输出电压，所以在满刻度电流时，检流电阻提供最大 64mV 的电压降。

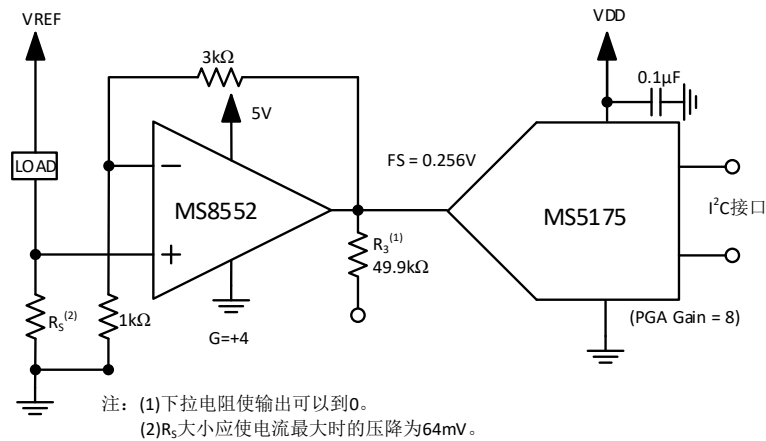
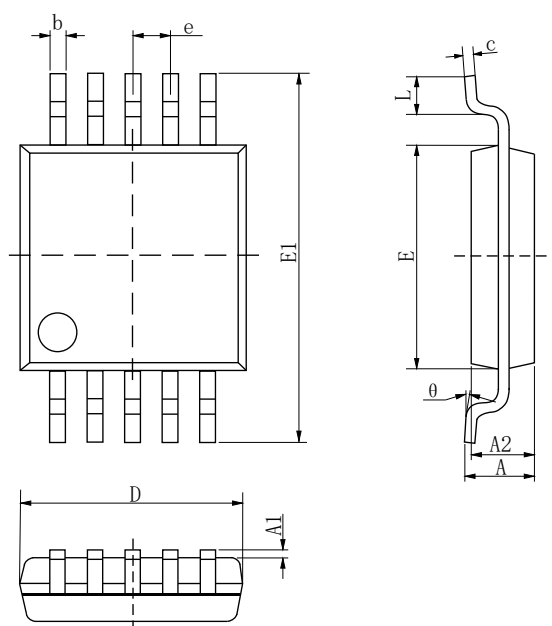


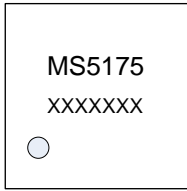
图 6. 低端电流测量

封装外形图
MSOP10


符号	尺寸 (毫米)		尺寸 (英寸)	
	最小	最大	最小	最大
A	0.820	1.100	0.032	0.043
A1	0.020	0.150	0.001	0.006
A2	0.750	0.950	0.030	0.037
b	0.180	0.280	0.007	0.011
c	0.090	0.230	0.004	0.009
D	2.900	3.100	0.114	0.122
E	2.900	3.100	0.114	0.122
E1	4.750	5.050	0.187	0.199
e	0.50BSC		0.020BSC	
L	0.400	0.800	0.016	0.031
θ	0°	6°	0°	6°

印章与包装规范

1. 印章内容介绍



产品型号：MS5175

生产批号：XXXXXXX

2. 印章规范要求

采用激光打印，整体居中且采用 Arial 字体。

3. 包装规范说明

型号	封装形式	只/卷	卷/盒	只/盒	盒/箱	只/箱
MS5175	MSOP10	3000	1	3000	8	24000

声明

- 瑞盟保留说明书的更改权，恕不另行通知！客户在下单前应获取最新版本资料，并验证相关信息是否完整。
- 在使用瑞盟产品进行系统设计和整机制造时，买方有责任遵守安全标准并采取相应的安全措施，以避免潜在失败风险可能造成的人身伤害或财产损失！
- 产品提升永无止境，本公司将竭诚为客户提供更优秀的产品！



MOS电路操作注意事项

静电在很多地方都会产生，采取下面的预防措施，可以有效防止 MOS 电路由于受静电放电的影响而引起的损坏：

- 1、操作人员要通过防静电腕带接地。
- 2、设备外壳必须接地。
- 3、装配过程中使用的工具必须接地。
- 4、必须采用导体包装或抗静电材料包装或运输。



+86-571-89966911



杭州市滨江区伟业路 1 号
高新软件园 9 号楼 701 室



[http:// www.relmon.com](http://www.relmon.com)